

ACTIVE COMPONENTS FOR HYBRID CIRCUITS
COMPOSANTS ACTIFS POUR CIRCUITS HYBRIDES



NPN planar power transistors (chips)

Transistors de puissance planar (pastilles)

Type Type	V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_{CM} (A)	h_{21E}	V_{CE} (V)	I_C (mA)
				min - max		
J.2N 2890	100	80	2	30 - 90	5	1
J.2N 2891	100	80	2	50 - 150	5	1
J.71 T2	80	60	2	30 - 90	2	1
J.72 T2	80	60	2	75 - 200	2	1

NPN Homonase[®] power transistors (chips)

Transistors de puissance NPN homobase[®] (pastilles)

Type Type	V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	h_{21E}	V_{CE} (V)	I_C (mA)
				min - max		
J.2N 3054	90	55	4	25 - 100	4	0,5
J.2N 3055	100	60	15	20 - 70	4	4

PNP epitaxial base power transistors (chips)

Transistors de puissance PNP à base épitaxiée (pastilles)

Type Type	V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	h_{21E}	V_{CE} (V)	I_C (mA)
				min - max		
J.BDX 14	- 90	-55	- 4	25 - 100	-4	-0,5
J.BDX 18	-100	-60	-15	20 - 70	-4	-4